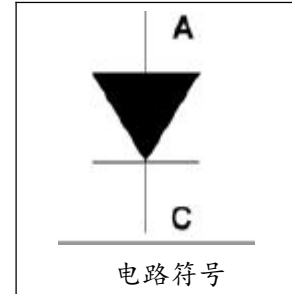


## KD650

### 特点:

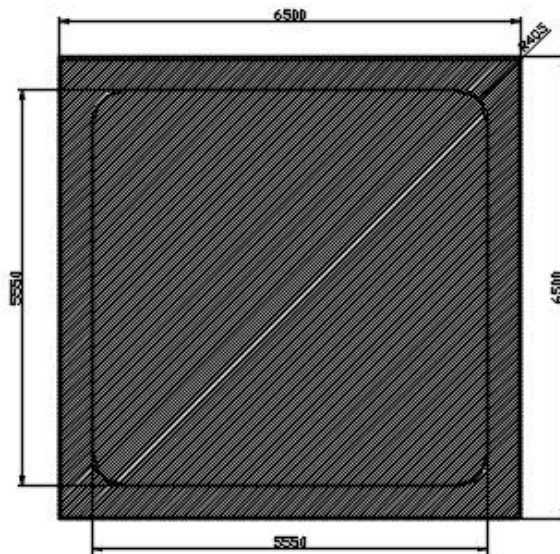
- 阻断电压高 (>1600V)
- 低导通压降; 高通态电流  $I_{TSM}$
- 复合钝化独立台面槽结构芯片, 高温漏电小, 可靠性高



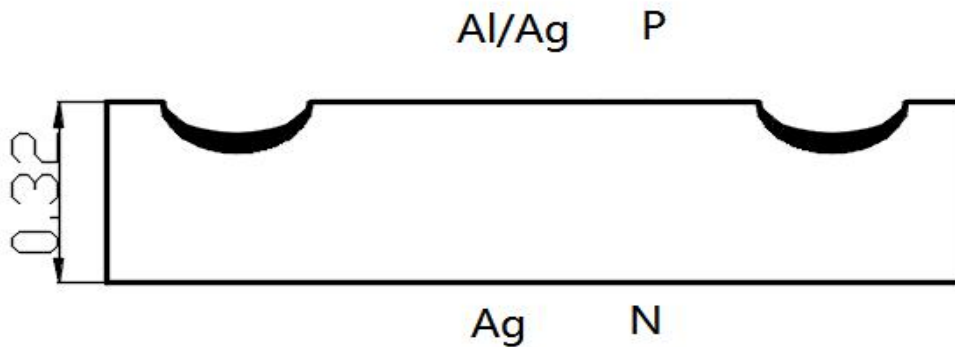
### 应用:

主要应用于各类电力电子模块。

### 外形尺寸图:



单位: 微米



单位: 毫米



## 极限值

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
$V_{RRM}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $I_R=0.1\text{mA}$	1600			V
$V_{RSM}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $I_R=0.1\text{mA}$	1800			V
$I_{F(AV)}$	$T_s=80^{\circ}\text{C}$ , $T_j=125^{\circ}\text{C}$	60			A
$I_{FSM}$	$T_j=45^{\circ}\text{C}$ , $t=10\text{ms}$ , $\sin 180^{\circ}$	740			A
$T_j$		-		150	$^{\circ}\text{C}$
TSTG		-		150	$^{\circ}\text{C}$

## 电特性

参数	测试条件	最小	典型	最大	单位
$I_R$	$V_{RRM}=1800\text{V}$ , $T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	5	$\mu\text{A}$
	$V_{RRM}=1800\text{V}$ , $T_j=125^{\circ}\text{C}$	-	-	1	mA
$V_F$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$ , $I_F=150\text{A}$	-	-	1.35	V
$V_{(TO)}$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-	-	0.9	V
$R_T$	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	-		3	m $\Omega$